⑫実用新案公報(Y2)

昭62 - 17973

(5) Int Cl. 4

生 わおり

識別記号

庁内整理番号

2040公告 昭和62年(1987)5月8日

H D1 J 23/54 7129-5C 7129-5C

(全4頁)

マグネトロン 図考案の名称

> の実 頤 昭55-59646

⑥公 閉 昭56-159958

23出 願 昭55(1980) 4月30日 ❸昭56(1981)11月28日

Ш 案 者 79考

敏 夫

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

株式会社東芝 の出願 人

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 鈴江 武彦 仞代 理 人

外2名

審査

伊坪 公

50参考文献 特開 昭49-115465 (JP, A) 実開 昭51-113363·(JP,U)

1

切実用新案登録請求の範囲

陽極 4 から突出して設けられた筒状金属封着体 18と、この封着体18に気密接合されたセラミ ツクス简体19と、上記陽極の陽極ペイン2から 上記封着体およびセラミツクス简体の内側を通つ 5 属円筒を取付け第3あるいは第4高調波抑制用チ て延長された出力アンテナリード24と、このア ンテナリードの先端部に電気的に結合され且つこ のアンテナリード先端部を同軸状にとりまいて設 けられた高調波チョーク用第1円筒20と、この れ且つその外側筒状端部が上記セラミツクス筒体 19に気密接合された半断面略 U字状の高調波チ ヨーク用第2円筒21とを具備してなるマグネト ロンにおいて、

側円筒部に段部21aを有し、この段部21aに 上記第1円筒20の開口端部が嵌合係止されて気 密接合され、且つ前記第2円筒の段部21aから 陽極 4 方向に所定長さの内側円筒端部 2 1 b が延 ロン。

考案の詳細な説明

この考案はマグネトロンに係わり、とくにその 出力部の改良に関する。

一般にマグネトロンは電子レンジなどに多用さ 25 る。 れているが、従来のマグネトロンにおける出力部 は、セラミツク简体に排気管を固着し、この排気

管にアンテナリード先端を接続している。この場 合、排気管の深さを入/4(但し入は第2高調波 の波長)に設定し、第2高調波抑制用チョークと して用いている。更にアンテナリードの途中に金 ョークとしているものもある。

2

ところが上記のようなマグネトロンでは、内部 構造が複雑であり、アンテナリードの途中に金属 円筒を設けるため、機械的に不安定である、又、 第1円筒の外側に気密接合されて同軸状に配設さ 10 チョークの円筒とその他の部品との間に高周波放 電を起す危険もある。

一方、特開昭49-115465号公報や実開昭51-113363号公報に開示されるように、出力アンテナ リードの先端部に第1のチョーク円筒を接続し、 上記高調波チョーク用第2円筒21は、その内 15 その外周に第2チョーク円筒を接合して異なる高 調波に対するチョーク構を形成した構造も知られ ている。しかしながら、これら公知マグネトロン は、外側第2チョーク円筒の内側に内側第1チョ ーク円筒の一部を嵌合させてろう接などにより接 長して設けられてなることを特徴とするマグネト 20 続する構成であるため、組立ての際にとくに内側 第1チョーク円筒の位置を定めにくい。そのた め、高調波に対する最適のチョーク作用を得る寸 法を決めることが困難で、複雑な位置決め治具を 必要とするなど、組立てが煩雑となる欠点があ

> この考案は上記従来の欠点を除去したマグネト ロンを提供することを目的とする。

以下、図面を参照してこの考案の一実施例を詳 細に説明する。この考案のマグネトロンは第1図 及び第2図に示すように構成され、第2図は第1 図の要部(出力部)を拡大して示したものであ る。

即ち、真空外囲器の一部を構成する陽極円筒1 の内壁に複数の陽極ベイン 2 が放射状に取着させ れ、複数のストラップ3により1つおきに連結さ れて陽極4が形成されている。そして陽極円筒1 用空間に一様な軸方向磁界を形成するためにそれ ぞれ中央に透孔を有する略円錐状の磁極5,6が 固着され、一方磁極5には陰極ステム7が他方の 磁極6には出力部8がそれぞれ突設されている。 極つまり炭化処理を施したトリウムタングステン からなる螺旋状の陰極フィラメント10が配設さ れ、この陰極フィラメント10は両端がそれぞれ モリブデン製のエンドハット11,12に固着さ 線を兼ねた簡状のモリブデン製外側陰極支持体1 3に支持され他方のエンドハット 1 2 は陰極フィ ラメント 10及び外側陰極支持体 13の内側を貫 通する給電線を兼ねたモリブデン製内側陰極支持 体14に支持されている。尚、両陰極支持体1 25 して内側チョーク構25の深さAを規定してい 3,14間には所定間隔に保つため一部にアルミ ナセラミツクス製のリング 15が配設されてい る。そして内側陰極支持体 1 4 は入力端子 1 6 に 固定され、外側陰極支持体13はコバールよりな る筒状のセラミツクス封着体 17に固定されてい 30 端帽 23 が配設され、それは第2円筒 21の外周 る。

一方、磁極 6 には既述のように出力部 8 が突設 されている。この出力部8は、陽極4に気密接合 された金属封着体18、これに気密接合されたセ 20、それと異なる高調波チョーク用第2円筒2 1、接続用ブロツク22、出力アンテナ端帽2 3、及び出力アンテナリード24等からなつてい る。この場合、アンテナリード24の一端は陽極 ラミツクス円筒19の内側を通つて延長された他 端には接続用ブロック22が固着されている。そ して、アンテナリード24の先端附近の外側には 段付有蓋简状の髙調波チョーク用第1円筒20が

配設されて接続用ブロック22に固着され、第1 円筒20及び第2円筒21の一部よりアンテナリ ード 2 4 の先端外側に特定の高調波例えば第 2 高 調波抑制用チョーク構25が形成されている。 5 尚、このとき第2図から明らかな如く、チョーク **講25の深さΛは約λgi/4(但しλgiは第2高** 調波の波長)に設定されている。そこで、このよ うな第2高調波抑制用チョーク構25を構成する 第1円筒20の外周には、環状にして且つ半断面 の両端には、気密壁の一部を兼ねると共に電子作 10 略 U字状にしてその内側円筒部の途中に段部 2 1 aを有する高調波チョーク用第2円筒21が同軸 的に配設固着され、その外側円筒部の閉口端がセ ラミツクス簡体19に気密に固着されている。と くに、内側円筒部の段部21aに、第1円筒20 又、陽極4の軸心に沿う電子作用空間9には、陰 15 の閉口端部が接合係止され気密接合されている。 そして、半断面が略U字状をなすこの第2円筒2 1により、第4高調波抑制用チョーク構26が前 記第2高調波抑制用チョーク構25の外側に同軸 状に形成されている。尚、チョーク蹟26の深さ れている。そして一方のエンドハット 1 1 は給電 20 B は約 λ g_2 / 4 (但し λ g_2 は第 4 高調波の波長) に設定されている。又、第2円筒21の段部21 aから陽極4の方向に所定長さの内側円筒端部2 1 bが延長して設けられている。この内側円筒端 部21 bは、第1円筒20と同等の内径寸法を有 て、第2高調波抑制用チョーク溝25と第4高調 波抑制用チョーク構26の両方の円筒体として共 用されていることになる。そして、第1円筒20 と第2円筒21の一部を覆うように出力アンテナ に固着され電気的に接続されている。第1円筒、 第2円筒およびセラミックス筒体19は互いに気 密に接合されて真空容器の一部をなしている。

この考案の実施例のマグネトロンによれば、第 ラミツクス筒体19、高調波チョーク用第1円筒 35 2高調波成分および第4高調波成分の輻射が大き く抑制された。

本発明者が確認した例を次に説明する。

2450MHz帯の基本波発振周波数で、出力電力約 800Wの電子レンジ用マグネトロンに関し、この ベイン2の1つに固着され、封着体18およびセ 40 考案の出力部構造のものと比較品との第2~4高 周波輻射レベルを比較した。測定方法は電波暗室 内に被測定マグネトロンをとりつけた電子レンジ オープンを設置し、このオーブンの内部に水負荷 を置くとともにオーブンの一つの側壁に直径10cm

の開孔を設けてこの開孔からマイクロ波が漏れう るようにし、さらにこれから3m離れたところに ホーンアンテナおよびこのホーンアンテナからの 信号を周波数成分ごとにそのレベルを測定する測 部構造は第1図および第2図に示すもので、同図 のA寸法を13.0meし、B寸法を何種類か用意し*

*た部品で変えマグネトロンをつつたもので、第2 円筒21のセラミック19への接続端部から底部 までの寸法は図示のようにB寸法の約半分に設定 したものである。そしてこのB寸法は5~8mmの 定器を接続したものである。なおこの考案の出力 5 間で変えて比較した。各々について5本づつの測 定を行なつた結果は下記第1表の通りの結果とな つた。

表

		A寸法	B寸法	輻射レベル(5本)(μV)		
		(non)	(nun)	最小值~最大值	平均值	比較品に対 する割合
第2高調波成分	比較品	0	0	510~1050	845	
		13.0	0	52~180	95	1 8.9
	•	13.0	7.0	65~190	105	18
第3高調波成分	比較品	13.0	0	125~200	150	
		13.0	5.0	72~160	105	1.4
	-	13.0	7.0	70~150	105	1.4
第4高調波成分	比較品	13.0	0	170~400	235	
		13.0	5.0	18~48	29	1/8.1
		13.0	6.0	20~54	36	1/6.5
		13.0	7.0	16~52	27	1/8.7
		13.0	8.0	21~48	32	1/7.3

この結果から、輻射される第2高調波成分は第 1円筒20を設けない場合の約1/8のレベルに低 下し、さらにこれは第2円筒21を設けることに よりこの第2円筒21を設けない場合(1/ 8.9) よりもきわめてわずかではあるが効果が低 35 部の位置が第2円筒の開口端部すなわちセラミッ 下することが明らかである。しかしこれはほとん ど無視しうる程度であり、むしろ後述する第4髙 調波成分の輻射抑制効果が顕著に得られているこ との方が重要である。第3高調波は1/1.4とい うわずかな低減が得られた。第4高調波成分に対 40 部が径小となる段部が形成され、この段部にチョ してこの考案は第2円筒21を設けない比較品に 比べて、1/6.5~1/8.7の低いレベルに抑える ことができた。こうして出力部をあまり複雑化お よび大形化することなく広い帯域の高調波抑制作

用を得ることができるという実用上のすぐれた効 果を奏する。なおこの外側の第2円筒の付加によ つても内側の第1円筒による高調波抑制効果がほ とんど悪影響を受けないのは、第1円筒の閉口端 クとの接合部の位置よりも陽極共振空胴の方に近 いためであると考えられる。

とくにこの考案は、半断面略U字状の高調波チ ヨーク用第2円筒21の内側円筒部にその開口端 ーク用第1円筒の開口端部を嵌合係止させて両円 筒を気密接合した構造であるため、その組立てを 高精度に且つ容易に行ない得る。とくにチョーク 溝の深さ寸法は、高調波に対するチョーク作用に

願著な影響を与えるので、これを高精度に定める 必要がある。そこでこの考案によれば、セラミツ クス简体の端面に機械的に安定に支持される高調 波チョーク用第2円筒の内側段部に、第1円筒の 開口端部を嵌合係止させることによりこの第1円 5 もできる。 筒の位置が定まるので、内側チョーク溝の深さ寸 法Aも自動的に定まる。しかも第1円筒は段部で ・ 機械的にも安定に保持される。したがつて余分の 位置決め治具を使用しないでも精度よく容易に位 置決めして気密接合することができる。

以上説明したようにこの考案によれば、チョー ク用第1円筒を高精度に且つ比較的容易に安定に 組立てることができ、異なる複数の高調波に対す る所要のチョーク作用を示すマグネトロンを得る ことができる。

なお、上記実施例では第2高調波抑制用チョー ク25の外側に第4高調波抑制用チョーク構を設 けたが、第4高調波抑制用チョーグ構の代りに第 3高調波などの抑制用チョーク構を形成すること

図面の簡単な説明

第1図はこの考案の一実施例に係るマグネトロ ンを示す縦断面図、第2図は第1図の要部(出力 部)を拡大して示す縦断面図である。

4 ……陽極、2 ……陽極ベイン、8 ……出力 10 部、18……金属封着体、19……セラミックス 简体、20……高調波チョーク用第1円筒、21 ……高調波チョーク用第2円筒、21 a……段 部、21b……内側円筒端部、24……アンテナ 15 リード。

